



DDR2 SO DIMM

TE 内部编号 1473005-4

Double Data Rate (DDR) 2, 5.2 mm [.205 in] Stack Height, Right Angle Module Orientation, 200 Position, DDR2 SO DIMM, SO DIMM Sockets

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽 > DDR2 SO DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 2

堆叠高度: 5.2 mm [.205 in]

模块方向: 直角

位数: 200

中心线 (间距) : .6 mm [.024 in]

[所有 DDR2 SO DIMM 插槽 \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 2

结构特性

托架数	2
钥匙数	1
行数	2
模块方向	直角
位数	200

电气特征

DRAM 电压	1.8 V
---------	-------

信号特征

--	--



SGRAM 电压	1.8 V
----------	-------

主体特性

插销电镀材料	锡
插销材料	不锈钢
模块钥匙类型	SGRAM
弹射器类型	锁定
弹射器位置	两端
连接器外形	标准

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
内存插槽类型	内存卡
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接触部电镀材料	镀金

端接特性

插入种类	凸轮
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准类型	标准键控
PCB 安装固定类型	焊钉
PCB 安装固定	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	高温热塑塑料
中心线（间距）	.6 mm[.024 in]

尺寸

堆叠高度	5.2 mm[.205 in]
行间距	6.2 mm[.244 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用



电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	20
封装方法	半硬托盘组件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

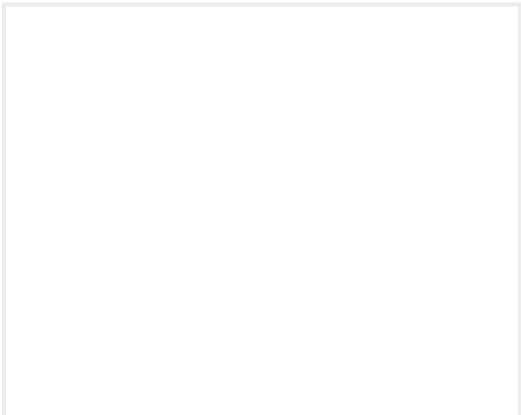
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

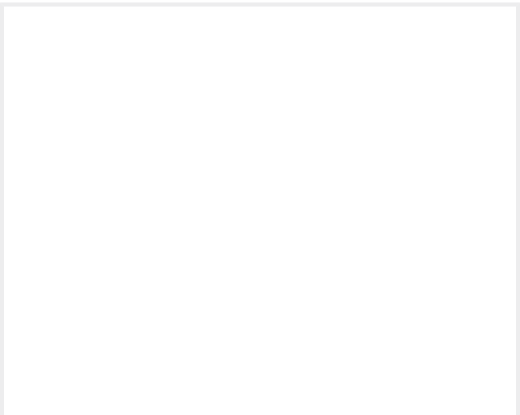




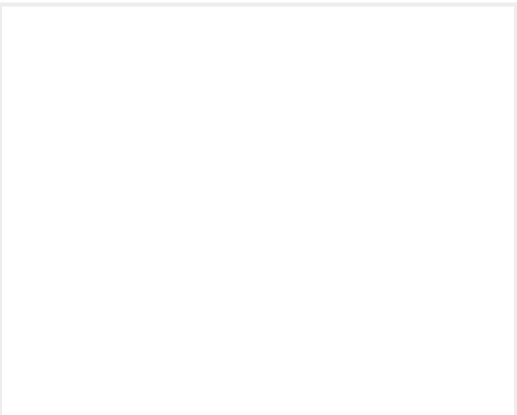
TE 产品编号 2309407-1
DDR4 SODIMM 260P 4.0H STD



TE 产品编号 1932208-1
EMBOSS TAPE DDR3 204P 5.2H RVS



TE 产品编号 1932210-1
EMBOSS TAPE DDR3 204P 9.2H RVS



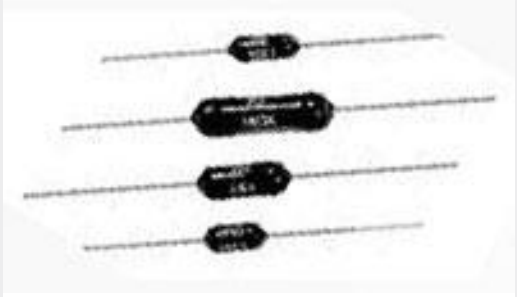
TE 产品编号 1932317-4
EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM
SOCKET 200P 9.2H

该系列中的其他产品 | DDR2 SO DIMM



SO DIMM 插槽(24)

客户还购买了



TE 产品编号9-1879662-9
H8 105R 0.1% 15PPM



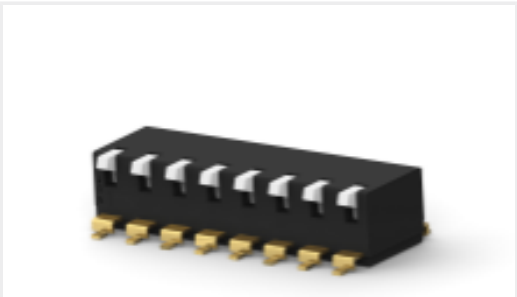
TE 产品编号6368459-1
INV MJ,1X2,PNL GRD,SHLD



TE 产品编号643234-1
06P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号1676914-3
YR1 0.1% 357K



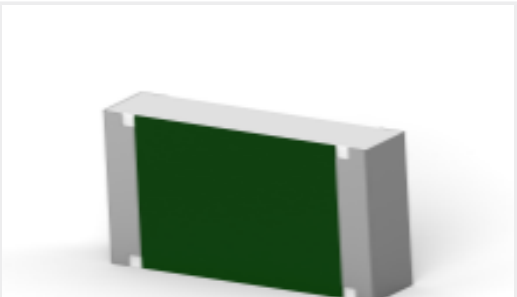
TE 产品编号3-2319764-4
E STACK PIANO 8P G LONG T&R PD
ON



TE 产品编号2-2176091-6
RP 2A 0.25W 105R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1623772-1
C7 100R 2% AMMO PK



TE 产品编号7-2176397-8
3502 1K6 1%



TE 产品编号6-1393788-9
V23079E1203B301



TE 产品编号7-2319848-5
END STACK DIP2PJRECESSSEALT&R



文档

SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473005-4_J1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473005-4_J1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473005-4_J1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本